

Fondamenti di Elettronica - Ingegneria Elettronica - a.a. 2009/10
Prima prova in itinere – 6 maggio 2010 – Traccia di soluzione

Esercizio 0

a) Valore medio della corrente in R_1

Poiche' siamo interessati al valore medio (cioe' alla componente in continua del segnale), la capacita' C sara' un circuito aperto. Il circuito e' lineare, quindi possiamo applicare il principio di sovrapposizione degli effetti, considerando per il generatore di corrente I_{in} solo il suo valor medio.

<p>Il generatore V^+ non da' alcun contributo poiche' e' in serie a un generatore di corrente.</p> $\overline{I_{out,a}} = \overline{I_{in}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	$\overline{I_{out,b}} = \frac{V^-}{R_1 + R_2}$

Considerando che

$$\overline{I_{in}} = I_{in,max} \frac{T}{3} = \frac{1}{3} mA,$$

la corrente media che fluisce in R_2 e' data da:

$$\overline{I_{out}} = \overline{I_{out,a}} + \overline{I_{out,b}} = \overline{I_{in}} \frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{V^-}{R_1 + R_2} = -0.75 mA.$$

b) Andamento temporale della tensione di uscita V_{out}

La costante di tempo del circuito è pari a

$$\tau = (R_1 // R_2)C = 75 ns$$

per cui la forma d'onda di uscita va a regime entro ogni frazione di periodo. Poiche' il circuito e' lineare, possiamo applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. Ovviamente V^+ non da' alcun contributo. Consideriamo ora la corrente I_{in} . Sul fronte la capacita' non puo' variare istantaneamente la tensione ai suoi capi, percio' la tensione di uscita, dovuta alla sola I_{in} , risulta nulla. Per determinare l'andamento completo della tensione di uscita calcoliamo il valore dell'uscita a regime.

Il valore di tensione cui va a regime, sempre considerando il solo generatore di corrente I_{in} si ottiene considerando la capacita' un circuito aperto:

$$V_{out}|_{regime, I_{in}} = I_{in, regime} (R_1 // R_2)$$

Consideriamo ora, invece, il contributo del generatore V^- ; si tratta di un generatore in continua, pertanto la capacita' e' un circuito aperto:

$$V_{out}|_{V^-} = V^- \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -1V$$

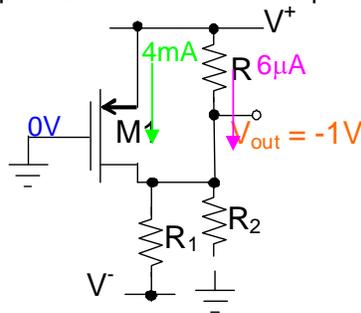
Il grafico della tensione di uscita risulta, quindi, il seguente:



Esercizio 2

a) Polarizzazione

La capacità è un circuito aperto, il generatore di tensione di segnale è spento e, quindi, il gate del pMOSFET si trova a 0V. Ipotizziamo il MOSFET in zona di saturazione.



Il transistor opera in zona di saturazione e la transconduttanza vale:

$$g_m = 2k_p (V_{GS} - V_{Tp}) = 2mS$$

b) Trasferimento V_{out}/I_{in} a bassa frequenza

$$v_{out} = -g_m (R_1 // R)$$

Quindi, il trasferimento ingresso-uscita di piccolo segnale a bassa frequenza risulta

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{LF} = -g_m (R_1 // R) \cong -2$$

c) singolarità introdotte da C

La capacità C introduce un polo con costante di tempo:

$$\tau_p = C(R_2 + R_1 // R) = 600ps$$

che corrisponde ad una frequenza del polo di 265 MHz, ed uno zero, poiché esiste un valore della variabile complessa s per cui si annulla l'impedenza $R_2 + \frac{1}{sC_2}$. La costante di tempo dello zero è

pari a

$$\tau_p = CR_2 = 400ps, \text{ a cui corrisponde una frequenza dello zero pari a 398 MHz.}$$

c) Massimo valore di R_1

Possiamo in prima approssimazione trascurare la corrente che fluisce nella resistenza R (salvo poi verificarlo!). La condizione sulla tensione di drain che mantiene il transistor in saturazione è

$$V_{out,max} = -V_{t,p} = 1V$$

Pertanto, poiché

$$V_{out,max} = V^- + IR_{1,max}$$

possiamo ricavare che

$$R_{1,max} = \frac{V_{out,max} - V^-}{I} = 1.5k\Omega$$

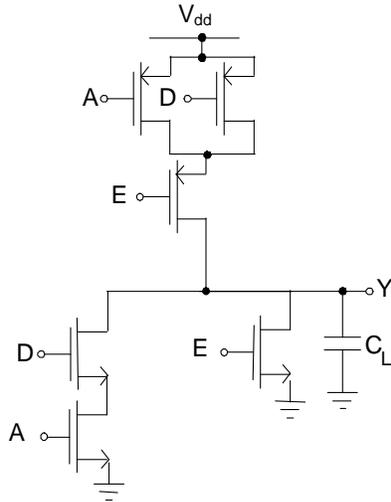
Esercizio 3

a) Rete di pull-up e pull-down

Per prima cosa occorre minimizzare l'espressione della funzione logica svolta dal circuito che, quindi, risulta:

$$Y = A \cdot (B + C + A) \cdot D \cdot \bar{E} = (A \cdot B + A \cdot C + A \cdot A) \cdot D \cdot \bar{E} = (A \cdot B + A \cdot C + A) \cdot D \cdot \bar{E} = A \cdot (B + C + 1) \cdot D \cdot \bar{E} = A \cdot D \cdot \bar{E} = (A + \bar{D}) \cdot \bar{E}$$

Pertanto, la funzione logica svolta è quella di una porta a 3 soli ingressi e la rete logica è la seguente (per la giustificazione delle scelte effettuate si veda il libro di testo – naturalmente la risposta qui data entro parentesi non sarebbe soddisfacente nel corso di un compito scritto ☺!!):



b) Calcolo dei tempi di commutazione LH e HL nelle condizioni meno gravose

Il caso meno gravoso per la commutazione LH si ha quando la carica della capacita' C_L avviene attraverso tutti e tre i pMOS.

Approssimazione ohmica: (e' sufficiente uno dei due approcci!)

$$R_{DS_{on}}|_p = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_{V_{DS}=0} = \left| \frac{1}{2k_p(V_{GS} - V_{T,p})} \right| = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_p (V_{dd} - V_{T,p})} = 1.613k\Omega$$

$$t_{p50\% LH} = (\ln 2)\tau = 0.69 R_{DS_{on}}|_{eq,p} C_L = 0.69 \cdot \frac{3}{2} \cdot R_{DS_{on}}|_p C_L = 3.51ns$$

Approssimazione satura: calcoliamo il fattore di forma dell'inverter equivalente relativo alla transizione basso-alto meno gravosa:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{p,eq} = \frac{1}{\left(\frac{L}{W}\right)_{p,E} + \frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{p,A}} + \frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_{p,D}}} = \frac{2}{3} \left(\frac{W}{L}\right)_p = \frac{10}{3}$$

$$t_{p50\% LH} = \frac{Q_{cond,50\%}}{I_{D,sat}} = \frac{C_L \left(\frac{V_{dd}}{2}\right)}{\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{p,eq} (V_{dd} - V_{T,p})^2} = 7.21ns$$

Il caso meno gravoso per la commutazione HL si ha quando la scarica della capacita' C_L avviene attraverso tutti e tre gli nMOS.

Approssimazione ohmica: (e' sufficiente uno dei due approcci!)

$$R_{DS_{on}}|_n = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_{V_{DS}=0} = \left| \frac{1}{2k_n(V_{GS} - V_{T,n})} \right| = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_n (V_{dd} - V_{T,n})} = 1075\Omega$$

$$t_{p50\% HL} = (\ln 2)\tau = 0.69 R_{DS_{on}}|_{eq,n} C_L = 0.69 \cdot \frac{2}{3} \cdot R_{DS_{on}}|_n C_L = 1.04ns$$

Approssimazione satura: calcoliamo il fattore di forma dell'inverter equivalente relativo alla transizione alto- basso meno gravosa:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{n,eq} = \left(\frac{W}{L}\right)_{p,E} + \frac{1}{\left(\frac{L}{W}\right)_{p,A} + \left(\frac{L}{W}\right)_{p,D}} = \frac{3}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_n = 4.5$$

$$t_{p50\% HL} = \frac{Q_{cond,50\%}}{I_{D,sat}} = \frac{C_L \left(V_{dd} - \frac{V_{dd}}{2}\right)}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_{n,eq} (V_{dd} - V_{T,n})^2} = 2.13ns$$

c) Calcolo della potenza dissipata dalla porta se B=C commutano a 1MHz, A=1, E=D=0.

Per la combinazione di ingressi considerata l'uscita non commuta mai, poiché gli ingressi *B* e *C* sono ininfluenti ai fini della commutazione della porta, pertanto la potenza dissipata dalla porta risulta nulla.

Esercizio 3

a) Diagramma temporale della corrente di uscita

Perché il diodo *D* si accenda occorre che la tensione ai suoi capi sia di almeno 0.7V, secondo la polarità corretta, pertanto *D* è acceso se

$$V_{in} - V_{out} \geq 0.7V$$

dove si è denominata V_{out} la tensione al catodo del diodo.

Quando il diodo è spento, il circuito è lineare e la tensione di uscita è pari a:

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_2 + R_1} + 1.5V \frac{R_1}{R_2 + R_1}$$

Pertanto la condizione di accensione del diodo si traduce in una condizione su V_{in} :

$$V_{in} - V_{out} \leq 0.7V$$

$$V_{in} \left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) - 1.5V \frac{R_1}{R_1 + R_2} \leq 0.7V$$

$$V_{in} \leq 3.6V$$

Quando il diodo è spento, la corrente I_{out} è pari a

$$I_{out} = \frac{V_{in} - 1.5V}{R_2 + R_1}$$

Quando V_{in} è pari a -5V, il diodo è ovviamente spento e

$$I_{out}|_{\min} = -2.17mA,$$

quando V_{in} è pari a 0V, il diodo è ancora spento e

$$I_{out} = -0.5mA,$$

alla soglia dell'accensione per V_{in} pari a 3.6V

$$I_{out} = 0.7mA$$

Quando il diodo si accende I_{out} è legato alla tensione V_{in} dalla relazione

$$I_{out} = \frac{V_{in} - 0.7V - 1.5V}{R_2},$$

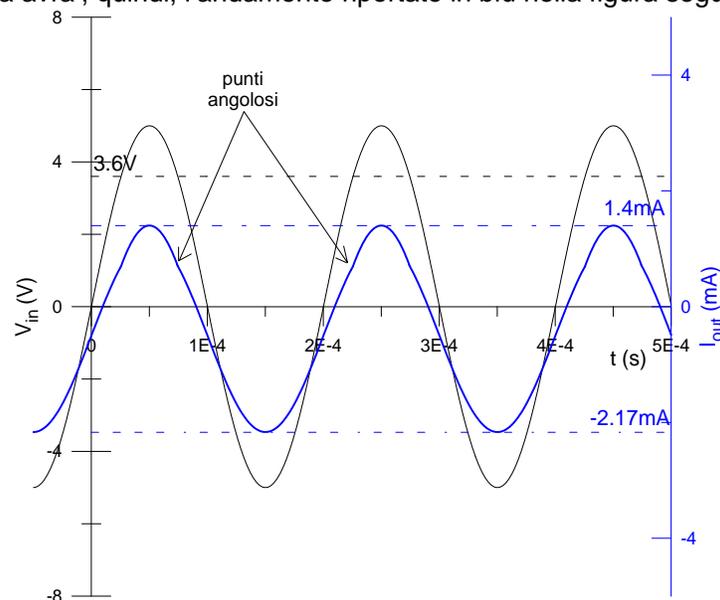
quindi per V_{in} è pari a 3.6V, correttamente

$$I_{out} = 0.7mA$$

e per V_{in} pari a 5V

$$V_{out} = 1.4mA$$

La corrente di uscita avrà, quindi, l'andamento riportato in blu nella figura seguente:



b) Diagramma temporale della potenza dissipata dal diodo

Dalla relazione precedente possiamo calcolare la massima tensione inversa applicata al diodo che risulta pari a

$$|V_{in} - V_{out}|_{\max, D_{off}} = V_{in} \left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) - 1.5 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 2.17 < |V_{BD}|$$

Pertanto, il diodo non va mai in *break-down*. Quindi, quando il diodo e' polarizzato in inversa esso non e' percorso da corrente e, quindi, non dissipa potenza.

Quando il diodo e' polarizzato in diretta, esso dissipa una potenza pari a:

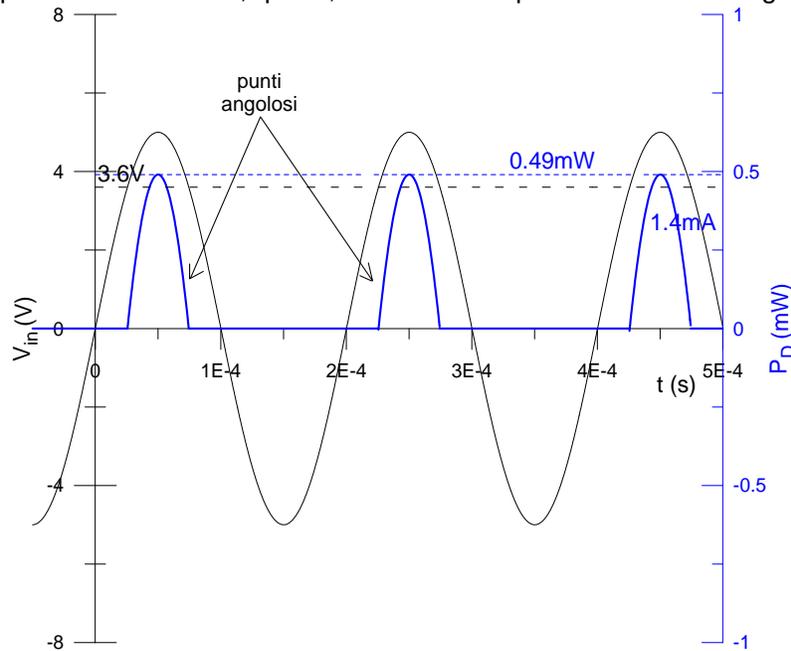
$$P_D = 0.7V \cdot I_D$$

La corrente I_D che fluisce nel diodo acceso e' pari a

$$I_D = I_{out} - I_{R_1} = I_{out} - \frac{0.7V}{R_1}$$

da cui ricaviamo che la massima corrente che fluisce nel diodo, quando V_{in} e' pari a 5V, e' 0.7mA e, pertanto, la massima potenza dissipata sara' pari a 0.49mW.

La potenza dissipata dal diodo avra', quindi, l'andamento riportato in blu nella figura seguente:



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.